

04; 07; 12

© 1993

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛЯННО-КАПИЛЛЯРНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

В.Л. Канцерев, Н.Р. Мингалиев,
О.Г. Петрухин, С.А. Пикуз,
В.М. Романова, Т.А. Шелковенко,
А.С. Шляпцева, А.Я. Фаенов

Стеклянно-капиллярные концентраторы (СКК) мягкого рентгеновского излучения (MRI) позволяют существенно улучшать характеристики лазер-плазменных и Z -пинчевых плазменных источников MRI [1, 2]. В частности, в работах [1, 2] экспериментально показано, что при использовании даже малогабаритных плазменных источников (с начальным энергозапасом до 2–3 кДж) достигаются большие значения плотности потока MRI в пятне фокусировки – $10^5 \dots 10^6 \text{ Вт}/\text{см}^2$ ($\lambda \lesssim 0.9 \text{--} 1.0 \text{ нм}$), которые характерны для опытов с синхротронными источниками.

В представляемой работе изучалась возможность применения СКК для изучения структуры излучающей области мощных плазменных источников MRI в широком диапазоне MRI ($\lambda \lesssim 1.0 \text{ нм}$), а также исследовалась его передающие и фокусирующие свойства в зависимости от длины волны MRI.

В качестве мощного плазменного источника MRI применялась установка БИН [3] в конфигурации X-пинч с Al , Cu , Pd и W проволочными анодами (рис. 1). Энергия, выделяемая на нагрузке, составляла около 3 кДж при напряжении 300 кВ, максимуме тока – 250 кА и длительности импульса около 100 нс. Набор диагностических средств включал кадровый ЭОП, рентгеновскую многоканальную камеру-обскуру с отверстиями диаметром около 100 мкм и фильтрами из алюминированного лавсана или Be толщиной соответственно 3 и 100 мкм, а также рентгеновский кристаллический спектрограф.

Максимум интенсивности MRI источника БИН приходился на следующие спектральные диапазоны (в зависимости от материала анода):

- 1) Al (К-спектр) $\lambda = 0.6 \text{--} 0.8 \text{ нм}$,
- 2) Cu (L -спектр) $\lambda = 0.8 \text{--} 1.5 \text{ нм}$,
- 3) Pd (L -спектр) $\lambda = 0.35 \text{--} 0.4 \text{ нм}$,
- 4) W (M -спектр) $\lambda = 0.5 \text{--} 0.6 \text{ нм}$.

В работе применялся СКК, аналогичный по конструкции использованному в работах [1, 2]. Число стеклянных капилляров – 450

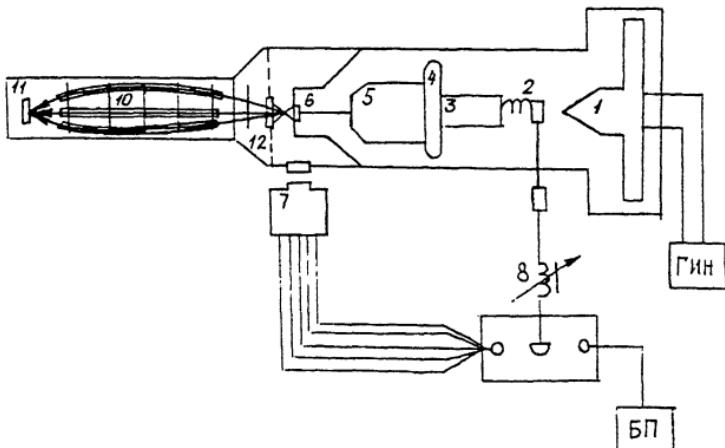


Рис. 1. Схема мощного плазменного источника МРИ-БИН со стеклянно-капиллярным концентратором.

1 – промежуточный конденсатор, 2 – промежуточный разрядник, 3 – формирующая линия, 4 – выходной разрядник, 5 – анодный узел, 6 – диод, 7 – система скоростной многокадровой фотографии, 8 – регулирующая линия задержки, 9 – разрядник линии ЭОП, 10 – стеклянно-капиллярный концентратор, 11 – датчик или облучаемый образец, 12 – защитный фильтр.

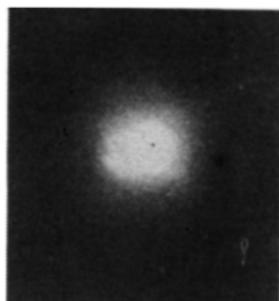
(внутренний диаметр каждого – 400 мкм, внешний диаметр каждого – 60 мкм), их длина 500 мм (рис. 1).

СКК размещался по оси разряда (рис. 1). Защита входного окна СКК от воздействия плазмы обеспечивалась специальным устройством, в котором использовались сменяемые фильтры из алюминированного лавсана толщиной 1 или 3 мкм. Рентгеновское излучение на выходе СКК регистрировалось датчиками с пленкой УФ-ВР, защищенной от видимого излучения двойным алюминированным лавсановым фильтром толщиной по 3 мкм, или термоплюминесцентными датчиками (ТЛД), обработка которых велась по методике, описанной в работе [4].

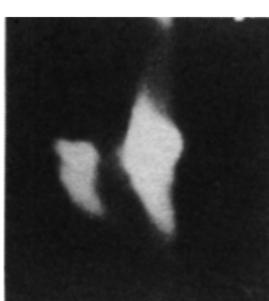
В ходе экспериментов установлено, что СКК ослабляет по меньшей мере на два порядка величины жесткую рентгеновскую компоненту ($\lambda \leq 0.1$ нм), интенсивность которой велика у мощных плазменных установок и которая обычно усложняет изучение структуры излучающей области источника.

Наилучшие результаты по передачи и фокусировке МРИ на установке БИН были получены с AZ анодом. Так, значение плотности энергии МРИ в пятне фокусировки достигало $E = 20-30$ мДж/см² ($q_{MRI} = 10^5-10^6$ Вт/см²), в спектральном диапазоне $\lambda \leq 1.0$ нм. Значение коэффициента концентрации МРИ-К (отношение плотности энергии импульса МРИ в пятне фокусировки к величине E , измеренной на таком же расстоянии без фокусировки) достигало 20–80. В данном эксперименте СКК работал как рентгеновская линза,

а

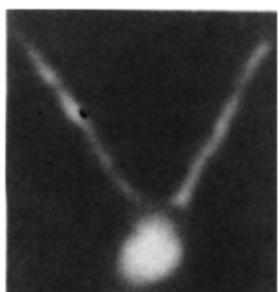


$$\lambda_{2p} = 1.0 \text{ нм}$$



$$\lambda_{2p} = 0.9 \text{ нм}$$

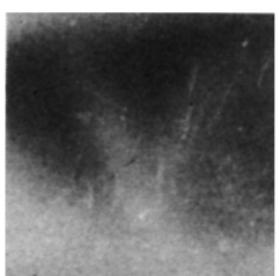
б



$$\lambda_{2p} = 1.0 \text{ нм}$$



$$\lambda_{2p} = 0.9 \text{ нм}$$



$$\lambda_{2p} = 0.45 \text{ нм}$$

Рис. 2. Изображения пятен фокусировки МРИ, полученные после СКК (слева) и вакуумные обскурограммы излучающей области разряда (справа).

а – анод – *Al*, *б* – анод *Pd*. λ_{gr} – граничная длина волны МРИ, пропускаемого защитным фильтром.

передающая изображение плазмы в масштабе 1:1. Полученное в фокусе СКК изображение излучающей *Al* плазмы представлено на рис. 2, а совместно с обскурограммой этого же *Al* разряда. Видно, что пятно фокусировки имеет хорошее заполнение и ту же форму, что и поперечное сечение СКК – шестиугольник с боковым „выбросом”, соответствующим второму плазменному пятну на обскурограмме разряда.

Наиболее ярко возможность использования СКК для изучения структуры излучающей области Х-пинча продемонстрирована опытами с *Pd* анодом в широком спектральном диапазоне МРИ $\lambda \leq 1.0$ нм. На рис. 2, б показаны два изображения *Pd* плазмы для $\lambda \leq 1.0$ нм

и $\lambda \leq 0.45$ нм совместно с обскуограммой разряда ($\lambda \leq 0.9$ нм). Хорошо видна идентичность этих изображений с учетом разрешения СКК (1-1.5 мм). Причем на изображении, полученном с помощью СКК, видны те элементы структуры, которые плохо или совсем не видны на обскуограмме в более жестком диапазоне спектра (рис. 2, б).

Разрешающая способность СКК может быть улучшена до 25-50 мкм за счет применения тонких капилляров (в частности, конусных), а также более точной сборки пакета капилляров.

Учитывая приведенные выше результаты по изучению структуры излучающей области плазменных источников и тот факт, что СКК является фильтром, отсекающим жесткий рентген, представляется особенно перспективным применение СКК для получения изображений горячей плазмы в так называемом „водном окне“ – $2.3 \leq \lambda \leq 4.4$ нм.

Список литературы

- [1] А наньин О.Б., Быковский Ю.А., Журавлев А.А., Знаменский В.А., Канцырев В.Л., Фролов С.П. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 2, С. 55-58.
- [2] А наньин О.Б., Быковский Ю.А., Канцырев В.Л., Кологризов А.А., Копыток К.И., Шляпцева А.С., Яковлев М.Я. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. В. 10. С. 79-83.
- [3] Иваненков Г.В., Лебедев А.Н., Пикуз С.А. Препринт ФИАН № 210. М., 1989.
- [4] Зверев С.А., Калашников М.П., Ляпидевский В.К., Михайлов Ю.А., Роде А.В., Склизков Г.В., Федотов С.И. Препринт ФИАН № 96. М., 1980.

Поступило в Редакцию
14 марта 1993 г.